## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11-162771

(43)Date of publication of application: 18.06.1999

(51)Int.Gl. H01G 4/12 H01G 4/30

(21)Application number: 09-323347 (71)Applicant: KYOCERA CORP
(22)Date of filing: 25.11.1997 (72)Inventor: IEMURA TSUTOMU

KAWASAKI YOSHINORI

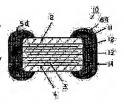
### (54) LAMINATED CERAMIC CAPACITOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a capacitor body from being cracked and external electrodes from

peeling off.

SOLUTION: A laminated ceramic capacitor has external electrodes 5a and 6a formed at the both ends of a capacitor body 2 wherein internal electrodes 3 and 4 are arranged via ceramic layers, and the external electrodes 5a and 6a are configured by forming electrode layers 11 formed by sequentially laminating a conductive paste of Ag or Ag alloy by dipping and baking it, conductive epoxy thermosetting resin layers 12, nickel plating layers 13, and thi group layers 14.



# (19)日本||納許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公鬻番号 特顯平11-162771

(43)公開日 平成11年(1999)6月18日

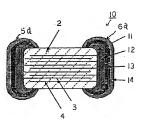
(51) IntCL <sup>e</sup>		識別記号	FΙ		
H01G	4/12	3 5 2	H01G	4/12	3 5 2
	4/30	301		4/30	301C
					301A

#### 春空階求 未請求 請求項の数1 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特顧平9-323347	(71)出願人	000006633	
(no) History	Webs in from a Porm		京セラ株式会社	na mis
(22) 出版日	平成9年(1997)11月25日		京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿	り香地
		(72)発明者	家村 努	
			应児島県国分市心下町1番1号	京セラ株
			式会社應児島国分工場内	A
		(72)発明者	河崎 芳筍	
			庭児島県国分市山下町1番1号	古ヤラ地
				21-276
			式会社處児島国分工場內	

## (54) [発明の名称] 稜隔セラミックコンデンサ

(57)【要約】 【課題】 コンデンサ本体にクラックが発生しない。外部 低価が剥離しない。 【解決手段】セラミック層を介在して内部電極3、4を 配設してなるコンデンサ本体2の同端面に外部電極5 a、6 aを形成した積層セラミックコンデンサ10であ って、外部電極5a、6aはAgまたはAg合金からな る導電ペーストをディッピングして塗布し、それを焼き 付けた電極層11と、導電性のエポキシ系熱硬化性樹脂 暦12と、ニッケルメッキ層13と、スズ系層14とを 順次積層した層構成である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】第1内部電板群と第2内部電板群との間に それぞれ誘電体層を介して交互に積層してコンデンサ本 体を形成するとともに、第1内部電極群の端をコンデン サ本体の一方端面に、第2内部電極群の端をその他方端 而に露出させ、両者関而にそれぞれ外部電極を形成した 稍層セラミックコンデンサであって、該外部電極は焼き 付け電極層と、金属粉末を含有する導電性のエポキシ系 **熱硬化性樹脂層と、ニッケルメッキ層と、スズまたは半** 田のメッキ層とを順次積層してなることを特徴とする積 階セラミックコンデンサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は外部電極を改善した 積層セラミックコンデンサに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の精層セラミックコンデンサを図3 により説明する。同図は積層セラミックコンデンサ1の 断面図であって、チタン酸パリウムなどの誘電体からな るセラミック焼紡体のコンデンサ本体2で構成され、こ のコンデンサ本体2の内部にはセラミック層(誘電体 順)を介して、AgまたはAg-Pd合金などの貴金属 材料あるいはニッケル (Ni) などの単金屋材料からな る内部電極3、4が配設されている。そして、内部電極 3は外部電極5に、内部電極4は外部電極6に電気的に 護通接続されている。

【0003】外部電極5、6はそれぞれ三層構造の電極 確から構成されている。すなわち、コンデンサ本体2の 表面にAgまたはAg-Pd合金からなる導電ペースト を塗布し、そして、焼き付けることで形成された電極層 7があり、この電極層7の表面に半田食われが生じ難い 材料からなるニッケルメッキ層8が形成され、さらに二 ッケルメッキ層8のトにスズ (Sn)または半田 (Sn -Pb合金)からなる電極層9が形成されている。

【0004】また、他の技術が特公昭58-40161 母公報および特開平4-257211号公報に提案され ている.

【〇〇〇5】前者の技術によれば、終縁体基板の蟷部や 回路素子の頭側に進電ペーストよりなした導電層を設 け、その上にAgーレジン系の導電性樹脂層を介して導 電腦を設けた構成であり、その導電性樹脂層で外側の導 供際に対する密着物度を高め、部品の交換可能回数を向 上させている。

【0006】後者の特開平4-257211号公報にお いては、チップ型電子部品本体の外部に内部電極と導通 する引出し無極を設け、この引き出し電極上にエポキシ /フエノール系の熱硬化性樹脂からなる緩衝材層を覆 い、さらにメッキ層を設けた構造であって、これによっ て外部からの機械的および熱的なストレスを吸収してい る.

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図3の 積層セラミックコンデンサ1によれば、上記電極層7を 標さ付けによって形成させるので、外部電極5、6とコ ンデンサ本休2との接合部、とくに外部電極5、6の周 辺部分に金属粉末の焼結収縮、誘電体層へのガラス成分 の拡散によってストレスが生じ、そのため、この積層セ ラミックコンデンサ1を回路基板に実装したものに対 し、温度サイクル試験や熱衝撃試験のような急激な熱変 化を受けた場合 あるいはそのような終しい環境のもと では、誘電体層、外部電極5、6、半田、回路基板、各 々の熱膨張係激差により応力吸収が不十分となり、外部 電極5.6の周辺部の残留ストレス部からコンデンサ本 体2にクラックが発生し、その結果、積層セラミックコ ンデンサ1が機能しなくなっていた。

【0008】他方、特公昭58-40161号公報と特 開平4-257211号公報のように導取性樹脂層を形 成した各技術においては、外部電極に対し、本体から外 側に向けられた応力が加わると、漢葉性樹脂層において 部分的な剥離が生じやすく、そのために実装基板との固 若力が低下し、チップ自体が影落していた。

【0009】したがって本発明は上記事情に鑑みて完成 されたものであり、その目的は冷熱サイクルなどの過激 な温度環境にあって応力が生じても、コンデンサ本体に クラックが発生せず、しかも、外部電極の剥離が生じな い高品質かつ高信頼性の積層セラミックコンデンサを提 供することにある。

[0010]

【郷頭を解決するための手段】本発明の精層セラミック コンデンサは、第1内部電極群と第2内部電極群との間 にそれぞれ誘電体層を介して交互に積層してコンデンサ 本体を形成するとともに、第1内部電板群の端をコンデ ンサ本体の一方標而に、第2内部電極群の端をその他方 端面に露出させ、両者の端面にそれぞれ外部電極を形成 した構成であって、この外部電極は焼き付け電極層と、 金属粉末を含有する導電性のエボキシ系熱硬化性樹脂層 と、ニッケルメッキ層と、スズまたは半田のメッキ層と を順次積層してなることを特徴とする。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の積層セラミツクコ ンデンサを図1と図2により詳述する。図1は本発明の **務層セラミックコンデンサ10の断面構造を示し、図2** は本発明の他の積層セラミックコンデンサ10 aの破断 面構造を示す。なお、これらの図において従来の積層セ ラミックコンデンサ1と同一箇所には同一符号を付す。 【0012】 図1の積層セラミックコンデンサ10にお いては、チタン酸パリウムなどの誘電体からなるコンデ ンサ本休2の内部にセラミック層を介在して、前記第1 内部電板群と第2内部電板群として、それを構成するP dまたはAg-Pd合金などの背金属材料あるいはニッ

ケル (Ni)などの卑金属材料からなる内部電極3、4 を配版している。

【0013】上記構成のコンデンサ本株2を作製するには、セラミックグリーンシートの所定の前級に内価電格 となる金属物末のペーストを多数の長万形が規則的に並 よように印刷し、この印刷シートを所定の枚数を復開 し、そして、これを精度方向にある寸法に切断してチッ 才材を形成し、ついでこのナップ材を所定の条列へ、温 该で結成して作動する。

[0014] つぎに上記構成のコンデンサ本株2の両端 画に外部電板5a、6aを形成する。コンデンサ本株2 の疾頭に入るまさはAを含金からなる構築ペーストをデ ィッピングして途市する。そして、塗布した浮球ペースト と所定の雰囲気わよび温度で焼き付け、前記焼き付け 窓値間としての電磁器11を形成する。そして、電極器 11の売頭に滞電性のエボキン系無限化性機能器 12を 形成し、その上に平出出会わか生と鬼い材料からなるこ マケルメッキ器13を電解メッキなどで形成し、さらに スズ(Sn)または半田のメッキ器14(以下、スズ系 層と略記する)を形成する。

【0015】上記エポキシ系熱硬化性樹脂層12は、エポキシ系熱硬化性樹脂の導電性樹脂ペーストを塗布、乾燥、硬化の各工程を順次経て形成する。

【0016】この導電性樹脂ペーストは金属粉末とエボ キシ系樹脂ンインダーと硬化剤との混合組成物、または これに有機体を入れた混合組成物であって、金属粉末 と無碘化性樹脂組成分を100:5~100:45の重 量比で配合させたものである。

【0017】上紀金属粉末は金、銀、白金、パラジウム、ロジウム、ニッケル、銅を単独でもしくは組み合わせて用いる。

[0018] エボキシ系制能パインゲーは分子中に2個またはそれ以上のエボキシ基を含する化含物からなり、 硬化制または触域の作用で硬化する。そして、このエボキン系制能はピスフェノールA型エボキシ系制能 ピスフェノールA型エボキン系制能 アスフェノールA D型エボキシ系制能の治状とボキシ系制造の治状とボキシ系制造の治状とボキシ系制能 り 選択する

【0019】硬化剤にはポリアミト硬化剤、脂肪族ポリアミン硬化剤、現状脂肪族ポリアミン硬化剤、素香族ポリアミン硬化剤、ジシアンジアミド等を使用する。

(0020)上配有機線体として、エタノール、inープロパール、プタノールをどの間割筋アルコール。 あらいは、これらアルコールのエステル、たとえばアセテート、アロピオネートなどがある。さらにメチルカルビトール、エチルカルビトール、ブサルカルビトール、ボケルカルドトールでサートなどのカルビトールとのオメートルア・スターペンタノン、3ーペンタノン、シクロペキサノンなどのケン条箱、メンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、 テレビン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、メ チルペンタンなどの炭化水素系溶媒が挙げられる。

【0021】かかる等電性樹脂ペーストは従来場加の手 後、たとよばスクリーン印刷、ディッセングをどによっ で確加し、特響させる。ついで80~140での漁康に て原度塩させ、その後、ペースト中の消儀成分を完全に 除金するためた60~120での温度乗即気で150~250 つり州間設倍剤をおこなう。しかる後に、150~250 での適度にて30~120分間加騰することで、硬化さ ・ 実質性のエボキン系発歴化性機能解を形成する。

で、今年はウルバイン系等のの機関・ショックコンデン サ10によれば、上記のような棒電性のエボキン系域で サ10によれば、上記のような棒電性のエボキン系域で 体化機能器用 2を設けると、この第12において、エボ キン系機能が逐化剤との反応により架橋した3次元割目 精志の硬化物となり、しかも、エボキシ系質節のなかで 向上音せることができ、これにより、急激な熱変化を受 けても、エボキン系熱要化性影響用 12がほう功収し、 本体から外観に向けられた外力に対して応力吸収でき、 その結果、コンデンサ本体2にクラックが発生しなくな り、外電磁像10、6の分割地もせじなくなった。

【0023】図2の他の原展セラミックコンデンサ10 由にれば、コンデンサ本体2の増加に外部電医5。 6 a を被優した場合、その一部をコンデンサ本体2の主 面上の婚にまで原准させている。図中、同時外和電路5方 向に関しては、コンデンサ本体2の増加と平行で、かつ コンデンサ本体2の厚み方向であって、X方向との直角 方向とY方向と差め、さらにコンデンサ本体2の増加 平行で、かつ特定電路3、4の面方向であって、X方向 との贈者方向を2方面と整め、100円 の開始方向を2方面と整め、100円 100円 1

「0024] そして、その矩在した電転開11の増と、 コンデッサ本株2の端面しか農大厚みの部所との大方向 にわたる開閉を0とし、そらに開発が現せによるエポキ シ系機硬化性協肥 12の間解Pとして、比率Q/Pを 0.25~0.8、折測には0.45~0.6にすると 下記の女に好きできる。

【0025】すなわち、過激な温度変化や温度サイクルの環体にあっても、上配のように設定することで、電極 間11の焼き付けにより、その場所に生じたストレスを、エバキシ系熱硬化性機筋関12により広力吸収でき、これにより、コンデンサ木体2にプラックが予生しなくなり、外部電極5a、6aが剥離しなくなった。【0026】

【実施明】(例1) 本売別の標層セラミックコンデンサ 10において、Agを主材としてガラスフリットを含む 郷電ペーストを5~20 xmの厚みで資布し、乾燥し、 焼き付けして電店間11を形成シタ、ついて、Ag系フィッテをエボキシ系削削に分散した湖電性開除ースト を電路側11を発生に関うように20~200 xmの厚 みで性布し、さらに乾燥し、ついで80~120℃の温度に更能溶利し、その後、150~200℃の過度で硬化させ、これによってエポキシ系熱硬化性頻能弱12を影成する。つづけてエッケルメッキ層13を電解メッキで形成し、このニッケルメッキ層13の上にスズ系層14を電解メッキで形成し、そして、規格に6とづく全長2、0mmの2012型にした。

【0027】そして、このような積層セラミックコンデンサを作製するに当たって、本発明のようなエボキシ系

熱硬化性期節間 12と、比較別上する各種の層を形成 し、試料No. 1~10とした。ただし、試料No. 7 今日で使用するエポキシ系無硬化性動態局は未発明の 試料No. 1、2のものに比べ、分子量が大きく、そし て、試料No. 7く試料No. 8<試料No. 9の順に さらに大きくなっている。 【0028】

【表1】

は料 No	熱硬化性樹脂層の材質	過算效	度(kg)	容量低下 (値)		併制性
		初期	試験致	27:17	粉雜	IN PACE
1	ピスフェノー# A型(低分子量)	2.64	2.62	0/50	0/50	0
2	じスフ≈ノール F型 (低分子量)	2.75	2.68	0/50	0/50	0
ж 3	フェノール樹脂	1.98	1, 26	0/50	4/50	0
₩ 4	アクリル側階	1, 61	0.92	0/50	6/50	×
ж 5	ポリイミド樹脂	1.72	0.60	0/50	6/50	۵
<b>※</b> 6	シリコン樹断	1.34	0.55	0/50	12/50	0
<b>※</b> 7	ピスフェノール A型(高分子量)	2, 26	2.04	0/50	2/50	0
× 8	ビルン・ル A 様(高分子量)	1, 67	1.09	0/50	3/50	0
₩. 9	ピスフェノール A型(英分子量)	1.16	0.30	0/50	17/50	Δ
<b>*10</b>	銀/53 電極 (750 C 禁成)	3. 45	3.26	24/50	0/50	0

#### ※印の試料Noは本発明の范囲外のものである。

を分母して分子にて儒教を表す。 【0031】高温負荷テスト(DC×2)については、 試料50種を125℃の雰囲気に置き、そして、100 の時間までの劣化状況を調べ、信頼性として3段階に区 分した。

	. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1	/	w/	11:11	413.1 [1411. [-1]	11/12	jun j	1111	11 12	1111	
S. PARTALLE DE LA PARTA DE La parta de la Parta De La La parta De La	- 1	, ,,,			r 11		//. /		1 11.0		1 m
•	EXIS No	Q (m)	P (mm)	Q/P	密着效应 (kg)	容量低下	荷頼性				

_//	, /					
MAN NO	Q	P	Q/P	密着效应	容量低下	荷物性
	(m)	(m)		(kg)	(#0)	· ·
<b>%11</b>	0. 05	0. 50	0.091	0.89	12/50	×
1 2	0. 10	0.50	0. 25	2. 68	0/50	0
1 8	0. 20	0. 50	0.4	2.69	0/50	0
14	0. 30	0. 50	6. 6	2, 73	0/50	0
1 5	0. 40	0.50	0. 8	2.57	-0/50	0
<b>%16</b>	0. 50	0. 50	1.0	2.32	4/50	0
<b>※17</b>	0.60	0.50	1.2	1.98	19/50	Δ

# ※印の試料Noは本発明の範囲外のものである。

,	11/11/		151	-	,	
11. 11/1/11		/	11 . 1/1/	. 11/1/ 11/1	/ /	11111.
14%	N	'/1	. /	11/1	1411111	/
	111, 1111,		1 411	111/2 1/	1 1/1/1/	/
1 770	11.11.11.11.11.	111.	1. 1	11/11/11 1/1	111 111	/ /
	11.14711111					
	/ /					
11/1/	11/11	/	' /	1/1/1/1 .	: 1/M	,
11 1 111.	1 1111111: 11	4 1/1	1 5 11	11:11 1	1//	111
111111111111111111111111111111111111111	11171, 11 115	/ /	///	1 1 1 111.	11 11/11/11/11	' 11
	1111 111	1/1/:/	/	/ //	11111	/
	11					
1 11	11111 1	111111111	341.	1111111	111.11.	
	771:11					

